










	<h2>SI1300BDL-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1300BDL-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3</p> <p>Datenblätter:  SI1300BDL-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 57107 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1300BDL-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	57107 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 400mA (Tc) 190mW (Ta), 200mW (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	190mW (Ta), 200mW (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 250mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.84nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	35pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1300BDL-T1-GE3TR






SI1300BDL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1300BDL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1300BDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1300BDL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI1300DL VISHAY SI1300DL VISHAY	 SI1301DL-T1 VISHAY SI1301DL-T1 VISHAY	 SI1300BDL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3	 SI1300DL-T1-GE3 V SI1300DL-T1-GE3 V
 SI1300BDL-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3	 SI1301DL VISHAY SI1301DL VISHAY	 SI123DL SI SI DIP	 SI13-0D BESTA BESTA QFP

heiße Teile

Mehr

 SI1069X-T1-GE3	 SI1069X-T1-GE3	 SI1070X-T1-E3	 SI1070X-T1-E3	 SI1070X-T1-GE3
 SI1070X-T1-GE3	 SI1071X-T1-GE3	 SI1071X-T1-GE3	 SI1072X-T1-E3	 SI1072X-T1-E3
 SI1072X-T1-GE3	 SI1072X-T1-GE3	 SI1073X-T1-GE3	 SI1073X-T1-GE3	 SI1120-A-GMR
 SI1132-A10-GMR	 SI1133-AA00-GMR	 SI113DP-T1-GE3	 SI1141-A10-GMR	 SI1142-A11-GMR
 SI1143-A11-GMR	 SI1143-M01-GMR	 SI1144-AAGX-GMR	 SI1300BDL-T1-E3	 SI1300BDL-T1-E3
 SI1300BDL-T1-GE3	 SI1300DL	 SI1300DL-T1	 SI1300DL-T1-GE3	 SI1301DL
 SI1301DL-T1	 SI1301DL-T1-E3	 SI1301DL-T1-GE3	 SI1301DL-T1/LGW	 SI1302DL
 SI1302DL-T1-E3	 SI1302DL-T1-E3	 SI1302DL-T1-GE3	 SI1302DL-T1-GE3	 SI1303DL
 SI1303DL-T1	 SI1303DL-T1-E3	 SI1303DL-T1-E3	 SI1303DL-T1-GE3	 SI1303DL-T1-GE3
 SI1303DL-TL-E3	 SI1303EDL-T1-GE3	 SI1304BDL-T1-GE3	 SI1304BDL-T1-GE3	 SI1304DL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited